학회지 논문투고양식 (돋움체 16pt)

홍길동(책임저자)† , 김길동\* , 이길동\*\* (돋움체 10pt)

†책임저자1한글소속, \*저자2한글소속, \*\*저자3한글소속(바탕체, 9pt)

English Title of The Paper (Times New Roman 14pt)

**Kil Dong Hong†, Kil Dong Kim\*, and Kil Dong Lee\*\* (Times New Roman 10pt)**

†KSDT School of Mechanical,\*KSDT Engineering,\*\*KSDT School

(영문소속기입 Times New Roman 10pt)

Abstract

Abstract should be written in English using Times New Roman 9pt. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here. Write English abstract here.

**Key Words** : English Key Word: Times New Roman 9pt , Semiconductor, Semiconductor, Semiconductor, Semiconductor

1. 서론

(돋움체 10pt또는 Times New Roman 10pt)

바탕체 9pt. 또는 Times New Roman 9pt. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오.

여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론 을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에

서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오.



**†E-mail**: 책임저자 이메일 기재

( Times New Roman, 9pt )

여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오. 여기에 서론을 입력하시오.

2. 제목

2.1 제목

여기에 2.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1절의 내용을 입력하시오.

All figures and tables should be written in English using

Times New Roman 9pt

Fig. 1 Microwave power dependence of the growth rate with constant group-Ⅲ flow rate (Times New Roman 9pt)

Fig. 2(a) XRD profiles measured by 2θ/ω-scan modes

Fig. 2(b) XRD profiles measured by ω-scan modes

Table 1. Growth conditions of GaN

2.1.1 제목

여기에 2.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 2.1.1항의 내용을 입력하시오.

3. 제목

3.1 제목

여기에 3.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1절의 내용을 입력하시오.

3.1.1 제목

여기에 3.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 3.1.1항의 내용을 입력하시오.

4. 결론

여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오.

감사의 글

여기에 감사의 글을 입력하시오. 여기에 감사의 글을 입력하시오. 여기에 감사의 글을 입력하시오.

참고문헌(영문으로 필히 작성 요망)

1. Font: Times New Roman 9pt. Tlusty, J., Smith, S., and Zamudia, C., "Critical Reviews in Solid State and materials Sciences," J. of The Korean Society of Semiconductor & Display Technology, Vol. 39, pp. 517-521, 2008.

2. Tlusty, J., Smith, S., and Zamudia, C., "Critical Reviews in Solid State and materials Sciences," J. of The Korean Society of Semiconductor & Display Technology, Vol. 39, pp. 51-52, 2008.